

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【公開番号】特開2004-117883(P2004-117883A)

【公開日】平成16年4月15日(2004.4.15)

【年通号数】公開・登録公報2004-015

【出願番号】特願2002-281545(P2002-281545)

【国際特許分類第7版】

G 03 F 7/039

H 01 L 21/027

【F I】

G 03 F 7/039 601

H 01 L 21/30 502 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年4月20日(2005.4.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

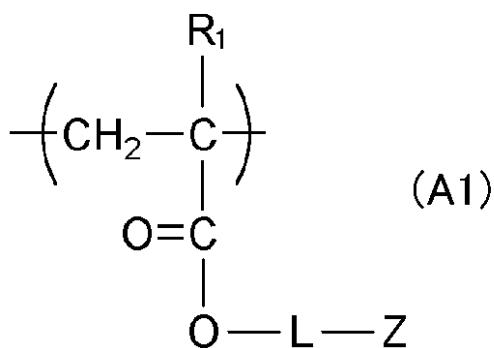
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) 下記一般式(A1)で表される繰り返し単位、下記一般式(A2)で表される繰り返し単位、及び下記一般式(A3)で表される繰り返し単位を含有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増大する樹脂、(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物及び(C)溶剤を含有するポジ型レジスト組成物。

【化1】



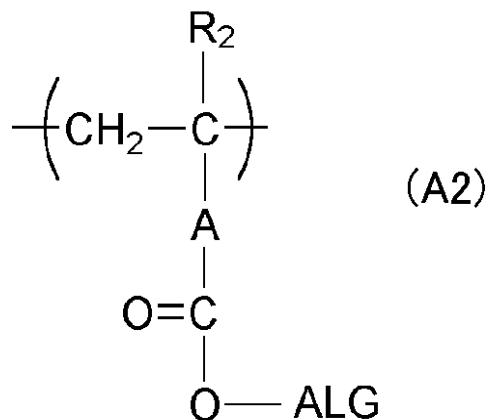
式(A1)において、R₁は水素原子又はアルキル基を表す。

Lは、単結合、アルキレン基、エーテル基、エステル基、カルボニル基、又はこれらの基の少なくとも二つの組み合わせを表す。

Zは、-COOH、-OH、-SO₂N(R₃)₂、-C(=O)CH₂C(=O)R₄、又は、-(CH₂R₅-CH₂R₆-O)_m-R₇を表す。R₃、R₅、R₆及びR₇は、各々独立に、水素原子又はアルキル基を表す。R₄は炭化水素基を表す。mは1~20を表す。

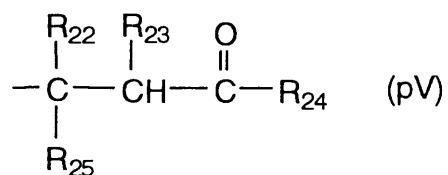
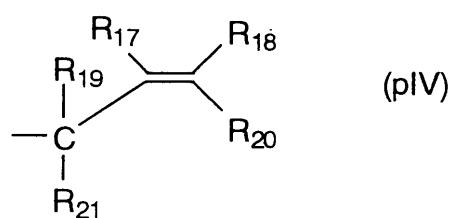
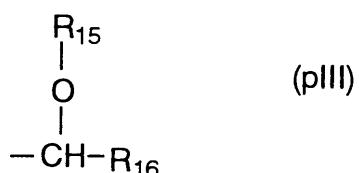
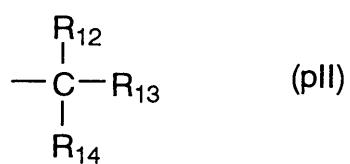
但し、Lが単結合のとき、Zは-(CH₂R₅-CH₂R₆-O)_m-R₇である。

【化2】



一般式(A2)において、R₂は水素原子又はメチル基を表し、Aは単結合又は連結基を表し、ALGは下記一般式(pI)～一般式(pV)のいずれかを表す。

【化3】



式中、R₁₁は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基

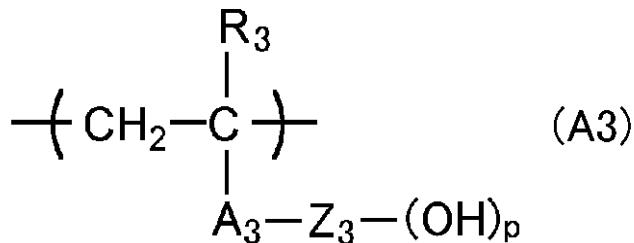
、イソブチル基又は sec - ブチル基を表し、Z は、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

R₁₂ ~ R₁₆ は、各々独立に、炭素数 1 ~ 4 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。但し、R₁₂ ~ R₁₄ のうち少なくとも 1 つ、及び R₁₅、R₁₆ のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。

R₁₇ ~ R₂₁ は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 ~ 4 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R₁₇ ~ R₂₁ のうち少なくとも 1 つは脂環式炭化水素基を表す。また、R₁₉、R₂₁ のいずれかは炭素数 1 ~ 4 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。

R₂₂ ~ R₂₅ は、各々独立に、炭素数 1 ~ 4 個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R₂₂ ~ R₂₅ のうち少なくとも 1 つは脂環式炭化水素基を表す。また、R₂₃ と R₂₄ は、互いに結合して環を形成してもよい。

【化 4】



一般式 (A3) において、R₃ は水素原子又はメチル基を表す。

A₃ は単結合又は 2 倍の連結基を表す。

Z₃ は p + 1 倍の脂環式炭化水素基を表す。

p は 1 ~ 3 の整数を表す。

【請求項 2】

樹脂 (A) が、更に、シクロヘキサンラクトン、ノルボルナンラクトン、又はアダマンタンラクトンを有する繰り返し単位を含有することを特徴とする請求項 1 に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。